

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U001056

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-01-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пархоменко Григорій Петрович

2. Parkhomenko Hryhorii Petrovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 21-12-2018

Спеціальність за освітою: 8.090802

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д76.051.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Тонкі плівки NiO та гетеропереходи на їх основі
2. Thin films NiO and heterojunctions based on them

Реферат:

1. Дисертація присвячена встановленню відтворюваних умов виготовлення тонких плівок оксиду нікелю та гетеропереходів на їх основі, дослідженню їх структурних, електричних, оптичних та фотоелектричних властивостей при різних умовах, розширенню можливостей їх застосування та покращення їх параметрів. В широкому діапазоні температур 77-290 K проведено дослідження явищ переносу в тонких плівках оксиду нікелю, напилених при різних температурах підкладки 373 K та 523 K та їх оптичних властивостей. Показано вплив обробки поверхні підкладок Si на електричні властивості гетероструктур p-NiO/n-Si. Досліджено їх електричні та фотоелектричні властивості та встановлено домінуючі механізми струмопереносу. Визначено електричні параметри гетеропереходів p-NiO/n-CdTe, p-NiO/p-CdTe, p-NiO/p-Cd_{1-x}Zn_xTe, p-NiO/n-Cd_{1-x}Zn_xTe та p-NiO/n-SiC. Досліджено темнові вольт-амперні характеристики гетеропереходів в широкому діапазоні температур.

2. The dissertation is devoted to the establishment of reproducible conditions for the production of thin films of nickel oxide and heterojunctions on their basis, to study their structural, electrical, optical and photoelectric properties under different conditions, to expand the possibilities of their application and to improve their parameters. A study was carried out on phenomena of transfer in thin films of nickel oxide, deposited at different temperatures of substrate 373 K and 523 K, and their optical properties, in a wide temperature range of 77-290 K. The influence of surface treatment of substrates Si on the electrical properties of p-NiO / n-Si heterostructures is shown. Their electrical and photoelectric properties were investigated and the dominant mechanisms of current transfer were established. The electrical parameters of the p-NiO / n-CdTe, p-NiO / p-CdTe, p-NiO / p-Cd_{1-x}Zn_xTe, p-NiO / n-Cd_{1-x}Zn_xTe and p-NiO / n-SiC heterojunctions are determined. The dark volt-ampere characteristics of heterojunctions in a wide temperature range are investigated.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мар'янчук Павло Дмитрович

2. Maryanchuk Pavlo Dmytrovych

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковалюк Захар Дмитрович
2. Ковалюк Захар Дмитрович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Смертенко Петро Семенович
2. Смертенко Петро Семенович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Катеринчук Валерій Миколайович
2. Катеринчук Валерій Миколайович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Мельничук Степан Васильович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Мельничук Степан Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.